






	<h2>SI7464DP-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7464DP-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 1.8A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SI7464DP-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 2905 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7464DP-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 1.8A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	2905 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 1.8A (Ta) 1.8W (Ta) Surface Mount
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	1.8W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.8A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	240 mOhm @ 2.8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI7464DP-T1-E3CT

SI7464DP-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI7464DP-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7464DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7464DP-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI7464DP-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 200V 1.8A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7463DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 40V 11A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7465DP-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 60V 3.2A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7465DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 3.2A PPAK SO-8</p>
 <p>SI7463DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 40V 11A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7464DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 1.8A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7463DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 40V 11A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7464DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 200V 1.8A PPAK SO-8</p>

heiße Teile

Mehr

SI7456DP-T1-E3	SI7456DP-T1-GE3	SI7456DP-T1-GE3	SI7458DP-T1-E3	SI7459DP-T1-E3
SI7459DP-T1-E3	SI7459DP-T1-GE3	SI7459DP-T1-GE3	SI7460DP	SI7460DP-T1-E3
SI7460DP-T1-E3	SI7460DP-T1-GE3	SI7460DP-T1-GE3	SI7461DP-T1-E3	SI7461DP-T1-E3
SI7461DP-T1-GE3	SI7461DP-T1-GE3	SI7462DP-T1-E3	SI7462DP-T1-E3	SI7462DP-T1-GE3
SI7462DP-T1-GE3	SI7463ADP-T1-GE3	SI7463ADP-T1-GE3	SI7463DP-T1-GE3	SI7463DP-T1-GE3
SI7464DP-T1-E3	SI7464DP-T1-GE3	SI7464DP-T1-GE3	SI7465DP-T1-E3	SI7465DP-T1-E3
SI7465DP-T1-GE3	SI7465DP-T1-GE3	SI7470DP-T1-GE3	SI7476DP-T1-GE3	SI7476DP-T1-GE3
SI7478DP	SI7478DP-T1-E3	SI7478DP-T1-E3	SI7478DP-T1-GE3	SI7478DP-T1-GE3
SI7483ADP	SI7483ADP-T1-E3	SI7483ADP-T1-E3	SI7483ADP-T1-GE3	SI7483ADP-T1-GE3
SI7483DP-T1	SI7483DP-T1-E3	SI7483DP-T1-GE3	SI7485DP-T1-E3	SI7485DP-T1-E3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited